เอกสารอ้างอิง

[1] Julian W. Gardner. *Microsensors, MEMS and Smart Devices*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 2001

[2] Wolf, S. and Tauber. *Silicon Processing For VLSI Vol. 1- Process Technology*. California: Lattice Press. 1986

[3] Wolf, S. and Tauber. *Silicon Processing For VLSI Vol. 3: The Submicron MOSFET*. California: Lattice Press. 1995

[4] Micheal Quirk and Julian Serda. *Semiconductor Manufacturing Technology*: Pretice-Hell Inc. Upper Saddle River, New Jersey .2001

[5] Alan B. Grebene. *Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design*. New York: John Wiley & Sons.1984

[6] **การุณ แซ่จอก**, มนตรี แสนละมูล, สุวัฒน์ โสภิตพันธ์, ภาวัน สยามชัย และ อิทธิ ฤทธาภรณ์ . “การศึกษาอุปกรณ์กำเนิดประจุชนิด เบอร์นาสในเครื่องยิงฝังประจุสำหรับกระบวนการผลิตวงจรรวม. ” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ครั้งที่ 27, พ.ศ. 2547, หน้า 269-272

[7] มนตรี แสนละมูล , **การุณ แซ่จอก** , อัมพร โพธิ์ใย, ภาวัน สยามชัย และ อิทธิ ฤทธาภรณ์. “เทคนิคการยิงฝังประจุปริมาณสารเจือสูงด้วยเครื่องยิงฝังประจุกระแสขนาดกลาง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ครั้งที่ 27, พ.ศ. 2547, หน้า 257-260

[8] **การุณ แซ่จอก**, มนตรี แสนลมูล, อนุชา เรืองพานิช, อกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ , สุรศักดิ์ เนียมเจริญ และ อัมพร โพธิ์ใย, “การพัฒนาการสร้างบ่อชนิดเอ็นโดยปรับเพิ่มอุณหภูมิการแอนนีล สำหรับวงจรรวม 0.8μm CMOS” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ครั้งที่ 29, ปี 2549, หน้า 685-688

[9] **การุณ แซ่จอก**, มนตรี แสนลมูล, อนุชา เรืองพานิช, สุวัฒน์ โสภิตพันธ์, สุรศักดิ์ เนียมเจริญ และ อัมพร โพธิ์ใย, “การศึกษาการยิงฝังประจุในการสร้างบ่อชนิดเอ็น สำหรับวงจรรวม 0.8μm CMOS”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ครั้งที่ 28, พ.ศ. 2548, หน้า 1073-1076

[10] W.G Pfann and P.N. Thurston. “Semiconducting Stress Transducers Utilizing the Transverse and Shear Piezorsistance Effects.” J. Apply. Phys, vol32, Oct 1996, pp.2008-2009.

[11] S.M.Sze. *Semiconductor Sensor*. USA: John Willy& Sons, Inc. 1994.

[12] Samuel K. Clark and Kensall D. Wise. “Pressure Sensitivity in Anisotropically Etched Thin-Diaphragm Pressure Sensors.” IEEE Trans. Electron Devices, Vol. ED-26, No.12, Dec 1979, pp.1887-1896

[13] ธัญญะ ศักดิ์โสภิษฐ์. “ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดซิลิคอนแบบเปียโซรีซีสทีปบนไดอะแฟรมบาง.” วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2534

[14] Duane Tandeske. *Pressure Sensor Selection And Application*. New York: Marcel Dekker Inc.1991

[15] โรเบิร์ต เอฟ.ค๊อฟลินและเฟรเดอริก เอฟ. ดริสคอลล์. การใช้งานออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี. แปลโดยวิโรจน์ อัศวรังสี และคณะ. กรุงเทพฯ: บริษัท เอซ.เอ็น.กรุ๊ป จำกัด.2536

[16] วิน บรรจงปรุ, อนุชา เรืองพานิช, โอภาส ตรีทวีศักดิ์ และ อัมพร โพธิ์ใย. “การศึกษา Si-Precipitate บริเวณรอยต่อ AlSiCu/Si เพื่อลดค่าความต้านทานรอยต่อโลหะสารกึ่งตัวนำสำหรับกระบวนการผลิตระบบเครื่องกลไฟฟ้าระดับจุลภาค.” การประชุมวิชา การทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ครั้งที่ 28, ปี 2548, หน้า 1173-1176

[17] นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง. “ การศึกษาคุณสมบัติลูมิเนสเซนซ์ของชั้นพอรัสซิลิคอน.” วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง. พ.ศ. 2544, หน้า 61-67

[18] Chien Chou, Hui-Kang Teng, Chih-Jen Yu and Hong-Sheng Huang. “Polarization modulation imaging ellipsometery for thin film thickness measurement” Optics Comunications, 2006, pp.032-042

[19] รศ.ดร.สมเกียรติ ศุภเดช. *เซมิคอนดักเตอร์ฟิสิกส์*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :แผนกตำรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง. 2544

[20] Liwei Lin, Huey-Chi Chu, and Yen-Wen Lu. “ A Simulation Program for the Sensitivity and Linearity of Piezoresistive Pressure Sensor” Journal of Microelectromechanical Systems, Vol.8, No.4, 1999, pp.514-522

[21] E.Kalvesten, L.Smith, L.Tenerz and G.Stemme. “ The First Surface Micromachined Pressure Sensor For Cardiovascular Pressure Measurements” IEEE, 1998, pp574-579

[22] B.Driz, I.Zarotskiy, J.Hoehn, V.I. Polyakov, A.I. Rukovishnikov and V.Novotny “Direct ion beam deposition of hard (>30GPa) diamond-like film from RF inductively coupled plasma source” Diamond and Related Materials,2001,pp 931-93

[23] M. Modreanu. “ Optical Propearties of silicon thin films related to LPCVD growth condition.” Thin Solid Films, 450, 2004. pp.105-110

[24] **การุณ แซ่จอก**, มนตรี แสนละมูล, ชาญเดช หรูอนันต์, เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์, สุรศักดิ์ เนียมเจริญ และ อัมพร โพธิ์ใย. “การศึกษาความต้านทานของโพลีซิลิคอน และ อมอร์ฟัสซิลลิคอนหลังการยิงฝังประจุ สำหรับ เซนเซอร์วัดความดัน.” การประชุมวิชา การทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ครั้งที่ 28, ปี 2548, หน้า 117-1120

[25] **Karoon Saejok**, Ekalak Chaowicharat, Montree Saenlamool, Kowit Sowsuwan, Charndet Hruanun, Surasak Niemcharoen and Amporn Poyai. “Study of Polycrystalline and Amorphous Silicon Film Resistance as Resistor in Piezoresistive Pressure Sensor.” ICAS2006, Vol. 1, November 2006, pp.590-598

[26] **การุณ แซ่จอก**, กิตติ เสนาบูรณ์, สุวัฒน์ โสภิตพันธ์, ภาวัน สยามชัย และ อิทธิ ฤทธาภรณ์ “การพัฒนากระบวนการปลูกฟิล์มโลหะหลายชั้นด้วยเทคนิคสปัตเตอร์ริงสำหรับการสร้างวงจรรวม”ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, ปี 2546, หน้า 1391-1395

[27] French, P.J. “Polysilicon: a versatile material for Microsystems.” Sensor and Actuators A 99, 2002. pp. 3- 12.

[28] Gupta, S. “Effect of Boron and BF2+ Implant on Polysilicon Resistors.” Journal of The Electrochemical Society, 149(4), **2002.** pp. G271 – G275